

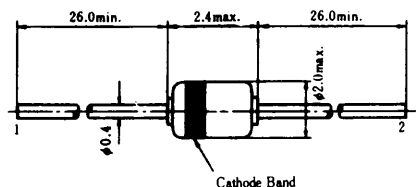
HSS81, HSS82, HSS83

シリコンエピタキシャルプレーナ形
高電圧スイッチング用

SILICON EPITAXIAL PLANAR
HIGH VOLTAGE SWITCHING

■特長

- 逆電圧が150V~250Vですので高電圧対応品です。
- 小形外形であるため、高信頼度であり高密度実装が可能です。
- 高速実装マシンによる5mmピッチ挿入対応品です。
(ガラス長: 2.2mm {typ.})



(MHD)

■FEATURES

- High reverse voltage ($V_R=150\sim 250V$).
- Suitable for 5mm pitch high speed automatic insertion. (Body length 2.2mm typ.)
- Small glass package (MHD) enables easy mounting and high reliability.

1. カソード: Cathode
 2. アノード: Anode
- (Dimensions in mm)

Type	Cathode Band
HSS81	Green
HSS82	Light Blue
HSS83	Black

■絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ C$)

項目	Symbol	HSS81	HSS82	HSS83	Unit
せん頭逆電圧	$V_R(\text{peak})$	200	250	300	V
逆電圧	V_R	150	200	250	V
せん頭順電流	$i_F(\text{peak})$	625	625	625	mA
サージ順電流	$I_F(\text{surge})^*$	1	1	1	A
平均整流電流	I_o	150	150	150	mA
接合部温度	T_j	200	200	200	$^\circ C$
保存温度	T_{stg}	-65~+175	-65~+175	-65~+175	$^\circ C$

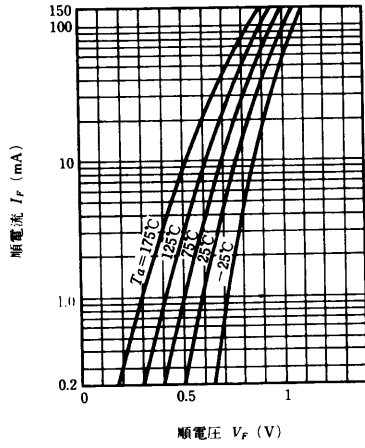
*持続時間1sec以内のサージ電流における許容値。

* Value at duration of 1sec.

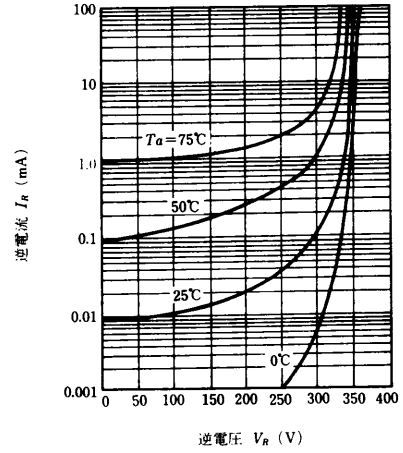
■電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ C$)

項目	Symbol	Test Condition	HSS81			HSS82			HSS83			Unit
			min	typ	max	min	typ	max	min	typ	max	
逆破壊電圧	$V_{BR(R)}$	$I_R=100\mu A$	200	-	-	250	-	-	300	-	-	V
逆電流	I_R	$V_R=150V$	-	-	200	-	-	-	-	-	-	nA
		$V_R=200V$	-	-	-	-	-	200	-	-	-	
		$V_R=250V$	-	-	-	-	-	-	-	-	200	
順電圧	V_F	$I_F=100mA$	-	-	1.0	-	-	1.0	-	-	1.0	V
端子間容量	C	$V_R=0V, f=1MHz$	-	1.5	-	-	1.5	-	-	1.5	-	pF
逆回復時間	t_{rr}	$I_F=I_R=30mA, I_{rr}=3mA$	-	-	100	-	-	100	-	-	100	ns

順特性
FORWARD CHARACTERISTICS



逆特性
REVERSE CHARACTERISTICS



端子間容量对逆电压特性
CAPACITANCE VS. REVERSE VOLTAGE

